

智慧財產及商業法院行政判決

113年度行專訴字第50號

民國114年4月23日辯論終結

原告 印能科技股份有限公司

代表人 洪誌宏

訴訟代理人 呂紹凡律師（兼上一人及次二人送達代收人）

吳雅貞律師

洪珮瑜專利師

被告 經濟部智慧財產局

代表人 廖承威

訴訟代理人 劉聖尉

參加人 歐門科技股份有限公司

代表人 林俊安

訴訟代理人 江國慶專利師

洪聖濠律師（兼上二人送達代收人）

上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國113年7月29日經法字第11317303850號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：

主 文

一、原告之訴駁回。

二、訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序事項：

原告原起訴聲明第二項為：「被告對申請第110103942號『利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法』發明專利請求項1至6應作成『舉發不成立』之審定。」（本院卷一第13頁），於被告為本案之言詞辯論前，在民國114年1月15日具狀變更（撤回）該項聲明（本院卷一第367頁），核於公益

之維護無礙，依行政訴訟法第113條第1項、第2項規定，應予准許。

貳、爭訟概要：

原告前於110年2月1日以「利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法」向被告申請發明專利，申請專利範圍共6項，經被告准予專利（公告號第1740779號，下稱系爭專利）。嗣參加人以系爭專利違反核准時專利法第22條第2項規定，對之提起舉發。被告以113年1月24日（113）智專議（二）04181字第00000000000號專利舉發審定書為「請求項1至6舉發成立，應予撤銷」之處分（下稱原處分，原證2），原告不服，提起訴願，經經濟部以同年7月29日經法字第00000000000號訴願決定駁回（原證3），原告不服，向本院提起訴訟。本院認本件訴訟的結果，如認定應撤銷訴願決定及原處分，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權命參加人獨立參加被告之訴訟。

參、原告主張要旨及聲明：

一、舉發人就舉發事由負有舉證之責任，專利專責機關「僅」就舉發人所述理由依其所舉之引證資料審查，專利專責機關職權審酌舉發人未提出之理由及證據時，「應」具體闡明並通知專利權人給予陳述意見及答辯機會。參加人之舉發理由書援引原證4（即舉發之證據1）為「主要引證」進行技術特徵比對，原證5（即舉發之證據1）則為「補強證據」只少量引用圖8至9、說明書【0066】至【0075】等部分段落，原處分竟以原證5為「主要引據」進行技術特徵比對，甚而於參加人不曾主張之前提下，逕自認定原證5單獨即足證明系爭專利請求項1不具進步性云云，已明顯逾越參加人主張範圍，被告依職權審酌參加人未提出之舉發理由，卻未依法闡明及通知原告限期答辯，違反專利法第75條、行政程序法第102條規定，且專利權人既已無從於訴訟程予中針對權利範圍進

01 行更正，專利權人之更正利益「當然」受到影響，原處分程
02 序違法情形，已影響原告更正利益，無從因嗣後於訴願或訴
03 訟程序中給予原告答辯機會而補正，應予撤銷。

04 二、由系爭專利請求項文字明確界定「一種利用增加氣體密度抑
05 制材料翹曲的方法」，以及說明書強調系爭專利遵循理想氣
06 體狀態方程式、以有效提升處理腔室內「氣體溫度」分佈的
07 均勻性，可知系爭專利界定之「預定溫度」應係指處理腔室
08 內「氣體」溫度；受加工物（半導體元件）為固體而非氣體，
09 若將「第一預定溫度」及「第二預定溫度」強加解釋為
10 「受加工物」於不同工作階段之溫度，勢必與系爭專利藉由
11 遵循理想氣體狀態方程式、控制處理腔室內氣體溫度及壓力
12 變化關聯性及技術手段之發明意涵，顯不相符。系爭專利申
13 請專利範圍所界定「第一預定溫度」及「第二預定溫度」，
14 應解釋為「符合第一預先設定溫度值之處理腔室內的實際溫
15 度值」及「符合第二預先設定溫度值之處理腔室內的實際溫
16 度值，且該溫度低於第一預定溫度」。而「預定溫度」係處
17 理腔室內「氣體」而非「受加工物」於不同工作階段之溫
18 度，由請求項中類似用語「預定壓力」之意涵，益證「預定
19 溫度」不可能為「受加工物於不同工作階段之溫度」，故本
20 院請求項解釋似已不當引入請求項所未記載之技術特徵，而
21 有違反專利法第58條第4項之疑慮。

22 三、縱依本院請求項解釋，原證4及原證5所欲解決課題為因晶片
23 高度不一致導致「晶圓與晶片無法適當接合」，與系爭專利
24 所欲解決為因溫差產生熱應力及壓差產生應力及振動發生
25 「晶圓翹曲」的問題，顯有不同。原證4及原證5與系爭專利
26 間之技術領域、所欲解決問題、功能及作用等既無明顯之關
27 連性，尤其，原證4及原證5皆沒有意識到溫差產生熱應力的
28 問題，通常知識者又如何會有動機參考原證4及5完成系爭專
29 利？在未有充分提示下，所屬領域具有通常知識者於面臨系

01 爭專利欲解決之技術問題時，無從自該等先前技術中組合出
02 系爭專利的特定技術方案。故原證4、原證5之組合或原證
03 4、5、6之組合無法證明系爭專利請求項1至6不具進步性。

04 四、聲明：訴願決定及原處分均撤銷。

05 肆、被告答辯要旨及聲明：

06 一、原處分第8至9頁記載與舉發理由所主張爭點「依據證據1
07 （即原證4）及證據2（即原證5）之組合系爭專利請求項1違
08 反進步性」並無差異。又原處分以原證5第8至9圖及第8至9
09 圖對應之說明書相關段落說明比對系爭專利請求項1之技術
10 特徵，與舉發理由第4、6至8頁所載並無差異，即便原處分
11 引用原證5比對系爭專利請求項1之部分技術特徵與舉發理由
12 引用原證4比對系爭專利請求項1之部分技術特徵有所不同，
13 惟原處分引用原證5內容並未逸脫舉發理由所提證據及理由
14 之範圍，在無引入新證據及新理由之前提下，自難稱舉發審
15 定有依「職權審查」而未踐行交付原告答辯之情事，故原處
16 分並無違誤。

17 二、本件以原證5為主要引證，依本院對於系爭專利申請專利範
18 圍所界定「第一預定溫度」及「第二預定溫度」之解釋為
19 「受加工物於不同工作階段之溫度」，原證4、原證5之組合
20 或原證4、5、6之組合足以證明系爭專利請求項1至6不具進
21 步性。

22 三、聲明：駁回原告之訴。

23 伍、參加人答辯要旨及聲明：

24 一、原處分據以認定系爭專利不具進步性之原證4與原證5是於舉
25 發程序中已提出之證據，即非「舉發人未提出之理由及證
26 據」，被告於舉發人提出之爭點範圍內，依照參加人所提出
27 證據及理由為判斷，非屬專利法第75條之職權審查，原告主
28 張被告做成處分有程序上瑕疵應予撤銷並無理由。

01 二、根據系爭專利請求項1之記載：「(b)使該處理腔室內的溫度
02 上升至一第一預定溫度…。讓該處理腔室籠罩在高溫及高壓
03 的工作環境中……(c)使該處理腔室內的溫度由該第一預定
04 溫度以至少一預定速率降低至一第二預定溫度，同時繼續該
05 處理腔室輸入至少依該氣體…」，「第一預定溫度」、「第
06 二預定溫度」為利用加熱裝置提升或降低後之溫度。因為密
07 閉系統，熱能會均勻擴及腔室及被處理元件（晶圓）。加熱
08 處理腔室內氛圍氣體溫度分佈均勻，晶圓亦被予以加熱，如
09 此抑制半導體元件發生翹曲。

10 三、根據本院之解釋，以第一預定溫度、第二預定溫度為指受加
11 工物於不同工作階段之溫度為基礎，以原證5為主要引證，
12 原證4、原證5之組合或原證4、5、6之組合足以證明系爭專
13 利請求項1至6不具進步性。

14 四、聲明：駁回原告之訴。

15 陸、爭點（本院卷二第9至10頁）：

16 一、程序方面：原處分有無違反專利法第75條及行政程序法第10
17 2條規定？

18 二、如何解釋系爭專利申請專利範圍所界定「第一預定溫度」及
19 「第二預定溫度」之意義？

20 三、原證4、5之組合是否足以證明系爭專利請求項1不具進步
21 性？

22 四、原證4、5、6之組合是否足以證明系爭專利請求項2不具進步
23 性？

24 五、原證4、5之組合是否足以證明系爭專利請求項3不具進步
25 性？

26 六、原證4、5之組合是否足以證明系爭專利請求項4不具進步
27 性？

28 七、原證4、5之組合是否足以證明系爭專利請求項5不具進步
29 性？

01 八、原證4、5之組合是否足以證明系爭專利請求項6不具進步
02 性？

03 柒、本院的判斷：

04 一、應適用的法令：

05 (一)系爭專利於110年2月1日申請，於同年8月10日審定准予專
06 利，故系爭專利有無撤銷之原因，應依核准時所適用之108
07 年11月1日施行之專利法（下稱核准時專利法）。

08 (二)依核准時專利法第21條規定，發明，指利用自然法則之技術
09 思想之創作。又依同法第22條第2項規定，發明為其所屬技
10 術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成
11 時，不得取得發明專利。另發明專利權有違反同法第22條第
12 2項規定者，任何人得向專利專責機關提起舉發（同法第71
13 條第1項第1款規定參照）。因此，系爭專利有無違反前述規
14 定而應撤銷其發明專利權，依法應由舉發人（即參加人）附
15 具證據證明之，倘其證據足以證明系爭專利有違前述規定，
16 自應為舉發成立之處分。

17 二、系爭專利所欲解決的問題、主要圖式、申請專利範圍及請求
18 項1之要件特徵解析，如附表1所示。至參加人所提引證（舉
19 發證據編號為證據1至證據3，如附表2所示。以下僅稱原證4
20 至原證6），其公開日皆早於系爭專利申請日，可作為系爭
21 專利之先前技術（相關技術內容及圖式如附表2所示）。

22 三、系爭專利申請專利範圍所界定「第一預定溫度」及「第二預
23 定溫度」之解釋：

24 (一)核准時專利法第58條第4項規定：「發明專利權範圍，以申
25 請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書
26 及圖式」。專利權範圍，係以申請專利範圍為準，而申請專
27 利範圍之文義解釋，涉及專利權範圍之界定，核屬法律適用
28 之問題，就申請專利範圍應如何解釋，乃法院依職權行使之
29 事項，無辯論主義之適用，法院不受當事人主張之拘束。本

01 件當事人雖未明白爭執系爭專利之用語，然觀其等書狀內
02 容，隱含對系爭專利申請專利範圍之「第一預定溫度」及
03 「第二預定溫度」用語存有不同見解，故本院依職權命當事
04 人就上開用語表示意見後，即通知本院所為之解釋，並命其
05 等以此為基礎，就系爭專利有效性爭點進行攻防（本院卷一
06 第459頁、本院卷二第10、61頁）。

07 (二)系爭專利說明書所記載之技術手段聚焦於抑制「半導體元件
08 翹曲」，其中說明書第【0002】段記載晶圓(半導體元件)在
09 處理腔室內進行高溫高壓製程時，會因處理腔室內溫度分佈
10 的均勻性欠佳，導致「晶圓各部位隨溫度變化而產生不同的
11 熱膨脹或熱收縮」，最終造成翹曲(warpage)」。說明書第
12 【0005】段再次強調系爭專利所欲解決的技術問題是習知晶
13 圓於處理腔室內進行高溫高壓相關製程時經常由於處理腔室
14 內溫度分佈的均勻性欠佳導致該晶圓因各部位溫度差異產生
15 熱應力而翹曲(warpage)。說明書第【0007】段記載系爭專
16 利旨在提供一種利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法。上
17 開說明書段落表明系爭專利的核心技術係「抑制半導體元件
18 翹曲」，而翹曲的直接原因係「半導體元件各部位溫度差
19 異」。因此，系爭專利要解決的溫度均勻性問題，理應聚焦
20 於受加工元件本身的溫度均勻性，方能有效抑制翹曲，而系
21 爭專利說明書中受加工元件可為半導體元件(系爭專利說明
22 書第【0001】段)或晶圓(說明書第【0002】段)。故系爭專
23 利申請專利範圍中「第一預定溫度」、「第二預定溫度」應
24 解釋為「受加工物於不同工作階段的溫度」實更符合系爭專
25 利之技術思想與實際應用情境，亦較能體現系爭專利「抑制
26 半導體元件翹曲」之發明目的。

27 (三)原告雖主張「預定溫度」係處理腔室內「氣體」而非「受加
28 工物」於不同工作階段之溫度，系爭專利請求項文字明確界
29 定「一種利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法」，說明書

01 強調系爭專利遵循理想氣體狀態方程式、以有效提升處理腔
02 室內「氣體溫度分佈的均勻性」，可知系爭專利界定之「預
03 定溫度」應係指處理腔室內「氣體溫度」，由請求項中類似
04 用語「預定壓力」之意涵，益可證明「預定溫度」不可能為
05 「受加工物於不同工作階段之溫度」，「預定壓力」應係指
06 「該處理腔室內」的壓力，而不可能為「受加工物」於不同
07 工作階段之壓力，請求項體系上類似用語之「預定溫度」，
08 也不應該被解釋為「受加工物於不同工作階段之溫度云云。

09 1.系爭專利之名稱及請求項均載明其發明目的係「抑制材料
10 翹曲」，對所屬技術領域具通常知識者而言，所謂「材料
11 翹曲」係源自受加工物（系爭專利稱半導體元件或晶圓）
12 各層材料間因溫度差異或壓力差異產生熱膨脹或熱縮收所
13 導致，故控制被加工物上不同材料層之溫度及壓力分佈始
14 為系爭專利解決翹曲問題的關鍵所在。再者，系爭專利說
15 明書第【0002】段亦記載「……惟當晶圓於處理腔室內進
16 行高溫高壓相關製程時，經常由於處理腔室內溫度分佈的
17 均勻性欠佳，造成晶圓各部位隨溫度變化而產生不同的熱
18 膨脹或熱收縮……晶圓上各層材料因壓差而產生應力及產
19 生振動現象，導致該晶圓因各部位溫度差異產生熱應力，
20 並結合氣體壓力變化引發晶圓各層材料間因壓差產生應力
21 及產生振動現象而翹曲……」，足見系爭專利探討因溫度
22 或壓力不均導致翹曲現象之主體均是受加工物（即半導體
23 元件或晶圓），系爭專利中控制處理腔室內氣體溫度或壓
24 力之分佈均勻之最終目的在於透過熱平衡或氣壓平衡機
25 制，以期達到受加工物各材料層間溫度或壓力分佈均勻，
26 最終受熱或受壓主體仍為處理腔室內的受加工物，故原告
27 前開主張殊難憑採。

28 2.此外，倘若「預定溫度」可解釋為處理腔室內「氣體溫
29 度」（僅為假設），則量測「氣體溫度」或如何定義「氣

01 體溫度」達到「均勻」必然為系爭專利之技術核心，然綜
02 觀系爭專利說明書全文，均未提及如何量測處理腔室內之
03 氣體溫度，亦未記載如何定義腔室內「氣體溫度」已達原
04 告所主張之「均勻」，足見系爭專利之技術核心並非在於
05 控制「氣體溫度」，故原告此部分主張即無可採。

06 (四)原告另主張系爭專利請求項中所界定之「預定壓力」係處理
07 腔室內的「氣體壓力」，故可類推「預定溫度」為「氣體溫
08 度」云云。惟對所屬技術領域具通常知識者而言，壓力和溫
09 度在物理性質上存有根本差異，氣體壓力在一密閉處理腔室
10 中可迅速達到均勻平衡，單一氣壓值或可代表整個腔室的壓
11 力狀態實為氣體固有之特性；溫度則不然，溫度受處理腔室
12 內之氣體或受加工物各層材料本身熱傳導速率、熱容及幾何
13 形狀等因素影響，腔室內之溫度易呈現不均勻分佈現象。簡
14 言之，即便處理腔室內氣體溫度本身已達到均勻，亦難稱受
15 加工物各層材料間已隨氣體溫度迅速同步達到溫度均勻而能
16 抑制翹曲，只有在受加工物各層材料達到溫度均勻時，方能
17 稱有抑制翹曲之效。基上，溫度與壓力係完全不同之物理
18 量，其量測方式與原理亦完全不同，故原告主張壓力與溫度
19 類推適用云云即不足採。

20 四、原證4、5之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性：

21 (一)「以原證5為主要引證，原證4為其他引證」之技術分析：

22 1.被告及參加人於本院審理時表明以原證5為主要引證（本
23 院卷二第150頁。關於原告所指原處分程序瑕疵，詳後第
24 十項所述），依此判斷系爭專利請求項1進步性之爭點，
25 即以選定之原證5，先與申請專利之發明的技術內容進行
26 差異比對，將其他引證即原證4，針對系爭專利申請專利
27 之發明所欲解決之技術問題，綜合考量原證5及原證4間之
28 技術領域是否具有關連性，彼此間所欲解決技術問題，抑
29 或技術內容所產生之功能、作用是否具共通性，以及相關

01 引證是否已明確記載或實質隱含結合不同引證技術內容之
02 教示或建議等因素，判斷該發明所屬技術領域中具有通常
03 知識者是否有動機以原證5所揭露之技術內容為基礎，結
04 合原證4加以置換、修飾或改良，而輕易完成申請專利之
05 發明（最高行政法院113年度上字第132號判決參照）。

06 2.經本院閱覽兩造及參加人之陳述與參加人所提之原證5、
07 原證4之技術內容後，依智慧財產案件審理法第6條第4項
08 規定，通知兩造及參加人就「原證5圖16之實施例所揭露
09 之處理腔室之壓力P，是否與晶圓W之溫度T上升曲線與系
10 爭專利請求項1所界定「同時上升」相符？」之技術問題
11 表示意見（本院卷一第460頁之說明五），業經兩造及參
12 加人具狀並於準備程序及言詞辯論程序詳為辯論，本院即
13 得以之為裁判基礎。

14 3.原證5與系爭專利請求項1要件編號1A之比對：

15 原證5說明書第【0072】段揭露「處理腔室100的內部為第
16 2壓力P2，因此可將晶片C往晶圓W推壓，而進一步抑制晶
17 片C的翹曲，並且亦可抑制熱應力變化所伴隨之晶圓W的起
18 伏」。原證5說明書第【0086】段揭露「……將處理腔室1
19 00的內部階段性地加壓至第2壓力P2，例如0.9MPa(圖15之
20 步驟B2，圖16(b))」。其中「……處理腔室100的內部為
21 第2壓力P2，因此可將晶片C往晶圓W推壓，而進一步抑制
22 晶片C的翹曲……」以及「將處理腔室100的內部階段性地
23 加壓至第2壓力P2」均可對應系爭專利請求項1要件編號1A
24 「一種利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法，其步驟包
25 括：」故原證5已揭露系爭專利請求項1要件編號1A全部技
26 術特徵。

27 4.原證5與系爭專利請求項1要件編號1B之比對：

28 原證5說明書第【0028】段揭露「接合系統1中，如圖3及
29 圖4所示，將作為基板的晶圓W與多個晶片C接合。晶圓W例

如係在矽晶圓或化合物半導體晶圓等形成有元件的半導體晶圓(元件晶圓)。在晶圓W的表面形成有多個凸塊」。原證5說明書第【0066】段及圖8揭露「接著，接合裝置30中，如圖11所示，藉由移動機構130使上部腔室101移動至上方，將處理腔室100開啟。然後，晶圓W被晶圓搬送裝置41搬入至處理腔室100的內部，並傳遞至預先上升而待機之升降銷160。此時，晶圓W的溫度為常溫，例如25°C」。其中「基板的晶圓W與多個晶片C接合」可對應系爭專利請求項1要件編號1B「複數個半導體元件」；其中「晶圓W被晶圓搬送裝置41搬入至處理腔室100的內部」可對應系爭專利請求項1要件編號1B「將複數個半導體元件移入一處理腔室內」，故原證5已揭露系爭專利請求項1要件編號1B全部技術特徵。

5.原證5與系爭專利請求項1要件編號1C之比對：

(1)原證5說明書第【0086】段揭露「……將處理腔室100的內部階段性地加壓至第2壓力P2，例如0.9Mpa（圖15的工程B2……」。原證5說明書第【0088】段揭露「於工程B2中，晶圓W雖然是以升降銷160保持著，由於處理腔室100內部的氣氛是藉由加熱機構151加熱，因此，晶圓W會被間接地加熱。然而，由於晶圓W是與載置台150（加熱機構151）分離的，因此，不會達到第1溫度T1，例如150°C以上」。原證5說明書第【0091】段揭露「當處理腔室100的內部到達第2壓力P2時……晶圓W會被加熱至第2溫度T2（圖15的工程B3……」。原證5說明書第【0092】段揭露「將處理腔室100的內部維持在第2壓力P2，並且將晶圓W維持在第2溫度T2的狀態持續一段預定的時間，例如30分鐘……」。其中「工程B2中……由於處理腔室100內部的氣氛是藉由加熱機構151加熱，因此，晶圓W會被間接地加熱。然而，由於晶圓W是與載置

01 台150（加熱機構151）分離的，因此，不會達到第1溫
02 度T1」、「……當處理腔室100的內部到達第2壓力P2時
03 晶圓W會被加熱至第2溫度T2（圖15的工程B3……」，
04 及圖16中對應工程B2、B3之時間段，在該時間段中，晶
05 圓W溫度先上升至接近T1之後再上升至T2。

06 (2)依前開說明書段落：

07 ①其中「晶圓W會被加熱至第2溫度T2」可對應系爭專
08 利請求項1要件編號1C「使該處理腔室內的溫度上升
09 至一第一預定溫度」；

10 ②其中「將處理腔室100的內部階段性地加壓至第2壓力
11 P2將處理腔室100的內部階段性地加壓至第2壓力P2，
12 例如0.9Mpa（圖15的工程B2……」及圖16中對應工程
13 B2之時間段，在該時間段中，處理腔室內的壓力與溫
14 度同時都上升，故可對應系爭專利請求項1要件編號1
15 C「同時對該處理腔室輸入至少一氣體，使該處理腔
16 室內的壓力上升至一預定壓力；

17 ③其中當處理腔室壓力到達P2，溫度達到T2時，可對應
18 系爭專利請求項1要件編號1C「讓該處理腔室籠罩在
19 高溫及高壓的工作環境中」；

20 ④其中「將處理腔室100的內部維持在第2壓力P2，並且
21 將晶圓W維持在第2溫度T2的狀態持續一段預定的時
22 間，」及圖16中對應工程B4之時間段，此時晶圓W溫
23 度、處理腔室之壓力均持平一段時間，故可對應系爭
24 專利請求項1要件編號1C「在該第一預定溫度及該預
25 定壓力的狀態下，對各該半導體元件進行一等溫等壓
26 製程」。

27 ⑤對該領域具通常知識者而言，原證5揭露將處理腔室
28 輸入氣體提高其壓力可以提升熱傳導效率，促進熱交
29 換，從而改善腔室內的溫度分佈均勻性，雖原證5並

01 未直接揭露「輸入氣體提高處理腔室壓力」與「溫度
02 均勻性」之關係，然其作用機制存在潛在關聯性，屬
03 原證5說明書揭露內容所實質隱含之技術內容，自可
04 對應系爭專利請求項1要件編號1C「藉由高壓氣體提
05 升該處理腔室內氣體溫度分佈的均勻性」。

06 (3)綜上，原證5已揭露系爭專利請求項1要件編號1C「(b)
07 使該處理腔室內的溫度上升至一第一預定溫度，同時對
08 該處理腔室輸入至少一氣體，使該處理腔室內的壓力上
09 升至一預定壓力，讓該處理腔室籠罩在高溫及高壓的工
10 作環境中，在該第一預定溫度及該預定壓力的狀態下，
11 對各該半導體元件進行一等溫等壓製程，藉由高壓氣體
12 提升該處理腔室內氣體溫度分佈的均勻性；」全部技術
13 特徵。

14 6.原證5與系爭專利請求項1要件編號1D之比對：

15 (1)原證5說明書第【0075】段揭露「將加熱機構151的溫度
16 下降到第三溫度T3，例如室溫，以將晶圓W冷卻到第三
17 溫度T3……晶圓W的冷卻速率例如設定為 $1.5^{\circ}\text{C}/\text{sec}$ 以
18 下。在此，如果快速冷卻晶圓W，接合的晶片C可能會翹
19 曲，但如此緩慢地冷卻晶圓W可以抑制晶片C的翹曲」。
20 原證5說明書第【0093】段揭露「將晶圓W冷卻至第3溫
21 度T3，例如 150°C (圖15的工程B5……若急速冷卻晶圓
22 W，晶片C可能產生翹曲，但晶圓W例如是以 $1.5^{\circ}\text{C}/\text{秒}$ 以
23 下的緩和冷卻速度被冷卻，因此，能夠抑制晶片C的翹
24 曲。此外，處理腔室100的內部為第2壓力P2，晶片C被
25 按壓於晶圓W，更進一步抑制晶片C的翹曲，同時也能抑
26 制伴隨熱應力變化的晶圓W之撓曲」。

27 (2)依前開說明書段落：

28 ①其中「將晶圓W冷卻至第3溫度T3，例如 150°C (圖15的
29 工程B5……晶圓W例如是以 $1.5^{\circ}\text{C}/\text{秒}$ 以下的緩和冷卻

速度被冷卻」可對應系爭專利請求項1要件編號1D「使該處理腔室內的溫度由該第一預定溫度以至少一預定速率降低至一第二預定溫度」；

②其中「處理腔室100的內部為第2壓力P2，晶片C被按壓於晶圓W，更進一步抑制晶片C的翹曲」及圖16工程B5對應時間段，處理腔室壓力於該時間段等壓維持於P2，可對應系爭專利請求項1要件編號1D「同時繼續對該處理腔室輸入至少一該氣體，使該處理腔室維持在該預定壓力，對各該半導體元件進行一降溫等壓製程」；

③其中「晶圓W例如是以 $1.5^{\circ}\text{C}/\text{秒}$ 以下的緩和冷卻速度被冷卻，因此，能夠抑制晶片C的翹曲……晶片C被按壓於晶圓W，更進一步抑制晶片C的翹曲，同時也能抑制伴隨熱應力變化的晶圓W之撓曲」可對應系爭專利請求項1要件編號1D「藉由提升氣體溫度分佈的均勻性及減少各該半導體元件各層材料間因壓差而產生應力及產生振動現象，俾能抑制各該半導體元件發生翹曲」。

(3)綜上，原證5已揭露系爭專利請求項1要件編號1D「(c)使該處理腔室內的溫度由該第一預定溫度以至少一預定速率降低至一第二預定溫度，同時繼續對該處理腔室輸入至少一該氣體，使該處理腔室維持在該預定壓力，對各該半導體元件進行一降溫等壓製程，藉由提升氣體溫度分佈的均勻性及減少各該半導體元件各層材料間因壓差而產生應力及產生振動現象，俾能抑制各該半導體元件發生翹曲」全部技術特徵。

7.綜上所述，原證5單獨已揭露系爭專利請求項1全部技術特徵，原證5及原證4均屬晶片接合之技術領域，且皆以增加處理腔室之氣體壓力與溫度進行晶片接合製程，故具功能

與作用之共通性，所屬技術領域具通常知識者自當有充足動機能組合原證5及原證4之技術內容以完成系爭專利請求項1之發明，故原證4及原證5之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

8.原告雖主張：原證4及原證5所欲解決課題為因晶片高度不一致導致「晶圓與晶片無法適當接合」，與系爭專利所欲解決為因溫差產生熱應力及壓差產生應力及振動發生「晶圓翹曲」的問題，顯有不同云云。惟原證4說明書第【0076】段揭露「由於是在工程S3中，在將晶圓W載置於載置台150之前，一邊使升降銷160下降，一邊進行晶圓W的溫度整平，因此，可抑制晶圓W之翹曲」，原證5說明書第【0011】段揭露「第4步驟中係在已加壓處理腔室之內部的狀態下基板緩緩冷卻，因此可抑制快速加熱/快速冷卻所導致之晶片C的翹曲，並且亦可抑制熱應力的變化所伴隨之晶圓W的起伏」，顯見在原證4及原證5中提到的「晶圓翹曲」係包含晶圓W整體翹曲而非單指晶片接合處的特定變形。故系爭專利、原證4及原證5之間均具解決相同問題之共通性與功能或作用之共通性，所屬技術領域具通常知識者自有充足動機組合原證4、原證5所揭露的技術內容以完成系爭專利之發明，原告前開主張即不足採。

9.原告又主張：原處分未附理由逕認原證4及原證5之結合足證系爭專利不具進步性云云，與最高行政法院之判決意旨相悖，原證4及原證5皆未意識到溫差產生熱應力的問題，通常知識者如何有動機參考原證4及5完成系爭專利云云。

(1)原處分第8至9頁之理由(五)、1.、(5)、(6)已說明「……證據2（即原證5）即已揭露系爭專利請求項1之所有技術特徵，發明所屬技術領域具有通常知識者於參酌證據2揭露內容後，即能輕易完成系爭專利請求項1所請發明……證據1（即原證4）及證據2為相同申請人之不同

發明，證據1第5、7圖揭露與證據2第5、7圖均揭露有相似之處理腔室結構，故兩者具高度關聯性，又證據2即足以證明系爭專利請求項1不具進步性已如前述，故證據1及2之結合足以證明系爭專利請求項1不具進步性」，顯見原處分係認為原證5單獨即可證明系爭專利請求項1不具進步性，加以原證4、5說明書內容高度相似，其技術領域、所欲解決問題共通性及功能或作用之共通性必然相仿，所屬技術領域具通常知識者自有充足動機組合原證4、5所揭露之技術內容以完成系爭專利之發明，故原處分已附理由，原告前開主張殊難憑採。

(2)原證4說明書第【0062】段揭露「……晶圓W的溫度會急遽上升，而導致該晶圓W產生翹曲……藉由進行晶圓W之溫度整平的方式，可抑制該晶圓W之翹曲」，其中「溫度整平」即指溫度均勻化，目的就是為了避免晶圓因快速或不均勻的溫度變化而產生翹曲，故原證4明確揭露若不進行溫度均勻化處理，晶圓溫度急劇變化會導致翹曲。原證5說明書第【0011】段揭露「第4步驟中係在已加壓處理腔室之內部的狀態下基板緩緩冷卻，因此可抑制快速加熱/快速冷卻所導致之晶片C的翹曲，並且亦可抑制熱應力的變化所伴隨之晶圓W的起伏」，故原證5明確揭露緩慢升溫可抑制晶圓翹曲。原證4、5均揭露因溫度變化不當(包括快速變化、導致溫度不均)所引起的晶圓或晶片翹曲問題，以及通過溫度整平(原證4)或緩慢升降溫(原證5)等手段來控制溫度變化，以抑制翹曲的發生，故系爭專利、原證4及原證5之間均具解決相同問題之共通性與功能或作用之共通性，所屬技術領域具通常知識者自有充足動機組合原證4、5所揭露的技術內容以完成系爭專利之發明，故原告主張即不足採。

(二)「以原證4為主要引證，原證5為其他引證」之技術分析：

01 1.依原告所述，按參加人舉發時所提舉發理由之論述次序，
02 以原證4為主要引證，判斷系爭專利請求項1是否不具進步
03 性之爭點。

04 2.原證4與系爭專利請求項1要件編號1A之比對：

05 原證4說明書第【009】段揭露「在將基板搬入至處理腔室
06 之內部並密閉該處理腔室的內部後……從氣體供給機構對
07 處理腔室的內部供給加壓氣體，並將該處理腔室的內部加
08 壓至預定壓力……即便基板上之複數個晶片的高度不一
09 致，亦由於該複數個晶片是藉由填充於處理腔室之內部的
10 加壓氣體予以推壓，因此，可均勻地以適當的壓力推壓基
11 板與複數個晶片……可一邊將基板與複數個晶片加熱至預
12 定溫度，一邊適當地進行推壓，從而可適當地接合該基板
13 與複數個晶片」。依據本院前開申請專利範圍之解釋，其
14 中「第一預定溫度」、「第二預定溫度」應解釋為「受加
15 工物於不同工作階段的溫度」，原證4說明書揭露「複數
16 個晶片是藉由填充於處理腔室之內部的加壓氣體予以推
17 壓，因此，可均勻地以適當的壓力推壓基板與複數個晶
18 片」，已揭露增加處理腔室內壓，推壓複數堆疊之晶片，
19 使其受力貼合，雖然原證4並未直接揭露「抑制材料翹
20 曲」，惟對所屬技術領域具通常知識者而言，複數晶片受
21 較強之氣體推壓力可抑制其翹曲係原證4實質隱含之內
22 容，可對應系爭專利請求項1要件編號1A「一種利用增加
23 氣體密度抑制材料翹曲的方法，其步驟包括：」，故原證
24 4已揭露系爭專利請求項1要件編號1A全部技術特徵。

25 3.原證4與系爭專利請求項1要件編號1B之比對：

26 原證4說明書第【0009】段揭露「在將基板搬入至處理腔
27 室之內部並密閉該處理腔室的內部後……即便基板上之複
28 數個晶片的高度不一致，亦由於該複數個晶片是藉由填充
29 於處理腔室之內部的加壓氣體予以推壓，因此，可均勻地

以適當的壓力推壓基板與複數個晶片」。其中「基板上複數晶片」可對應系爭專利請求項1要件編號1B「複數半導體元件」。其中「將基板搬入至處理腔室之內部」可對應系爭專利請求項1要件編號1B「將複數個半導體元件移入一處理腔室內」，故原證4已揭露系爭專利請求項1要件編號1B全部技術特徵。

4.原證4與系爭專利請求項1要件編號1C、1D之比對：

原證4與系爭專利請求項1相較並未揭露系爭專利請求項1要件編號1C「使該處理腔室內的溫度上升至一第一預定溫度，同時對該處理腔室輸入至少一氣體」，此為原證4與系爭專利請求項1主要差異技術特徵1。此外，原證4亦未揭露系爭專利請求項1要件編號1D「處理腔室內的溫度由該第一預定溫度以至少一預定速率降低至一第二預定溫度，同時繼續對該處理腔室輸入至少一該氣體，使該處理腔室維持在該預定壓力」，此為原證4與系爭專利請求項1主要差異技術特徵2。

5.原證5與系爭專利請求項1要件編號1C之比對：

如前第四、(一)、5.項所述，原證5已揭露系爭專利請求項1要件編號1C「(b)使該處理腔室內的溫度上升至一第一預定溫度，同時對該處理腔室輸入至少一氣體，使該處理腔室內的壓力上升至一預定壓力，讓該處理腔室籠罩在高溫及高壓的工作環境中，在該第一預定溫度及該預定壓力的狀態下，對各該半導體元件進行一等溫等壓製程，藉由高壓氣體提升該處理腔室內氣體溫度分佈的均勻性；」全部技術特徵，此即前開原證4與系爭專利請求項1主要差異技術特徵1。

6.原證5與系爭專利請求項1要件編號1D之比對：

如前第四、(一)、6.項所述，原證5已揭露系爭專利請求項1要件編號1D「(c)使該處理腔室內的溫度由該第一預定溫

01 度以至少一預定速率降低至一第二預定溫度，同時繼續對
02 該處理腔室輸入至少一該氣體，使該處理腔室維持在該預
03 定壓力，對各該半導體元件進行一降溫等壓製程，藉由提
04 升氣體溫度分佈的均勻性及減少各該半導體元件各層材料
05 間因壓差而產生應力及產生振動現象，俾能抑制各該半導
06 體元件發生翹曲」全部技術特徵，此即前開原證4與系爭
07 專利請求項1主要差異技術特徵2。

08 7.綜上所述，原證4與原證5之組合已揭露系爭專利請求項1
09 全部技術特徵，且原證4及原證5均係晶片接合之技術領
10 域，且皆以增加處理腔室之氣體壓力與溫度進行晶片接合
11 製程，故具功能與作用之共通性，所屬技術領域具通常知
12 識者當有充足動機能組合原證4及原證5之技術內容以完成
13 系爭專利請求項1之發明，故原證4及原證5之組合足以證
14 明系爭專利請求項1不具進步性。

15 (三)從而，無論主要引證為原證5或原證4，經整體判斷此二引證
16 之技術內容，原證4及原證5之組合足以證明系爭專利請求項
17 1不具進步性。

18 五、原證4、5、6之組合足以證明系爭專利請求項2不具進步性：

19 (一)系爭專利請求項2依附於請求項1，包含請求項1全部技術特
20 徵，而請求項1不具進步性，已如前述。

21 (二)原證4、5並未揭露該輸入氣體之具體成分，然空氣或氮氣係
22 低成本與低化學活性之氣體，以空氣或氮氣作為加壓氣體對
23 於該技術領域具通常知識者而言實屬習知之通常知識，況系
24 爭專利說明書雖記載該用以加壓之輸入氣體係空氣或氮氣，
25 然未記載使用空氣或氮氣作為加壓氣體究竟有何有利功效或
26 不可預期之功效，益徵使用空氣或氮氣作為加壓氣體為習知
27 通常知識。再者，原證6揭露一種抑制材料翹曲的方法，原
28 證6說明書第【0009】段揭露「透過該氣壓源經由各該氣體
29 入口對各該氣囊填充氣體，使氣體經由各該氣體通道流入各

該氣囊，讓各該氣囊內部充滿氣體至第一預定壓力」。原證6說明書第【0014】段揭露「該氣壓源係為一空氣壓縮機或廠務氣體管路」，其中「透過該氣壓源經由各該氣體入口對各該氣囊填充氣體……該氣壓源係為一空氣壓縮機或廠務氣體管路」可對應系爭專利請求項2「如請求項1之利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法，其中至少一該氣體係為一空氣及/或一氮氣」全部技術特徵。

(三)綜上，原證4、5、6之組合已揭露系爭專利請求項2全部技術特徵，原證4、5、6均揭露提高處理腔體內之壓力至特定值，其作用均是要防止晶片翹曲（原證4實質隱含，原證5、6直接揭露），故具有功能或作用之共通性，所屬技術領域具通常知識者當有充足動機能組合原證4、5、6之技術內容以完成系爭專利請求項2之發明，故原證4、5、6之組合足以證明系爭專利請求項2不具進步性。

六、原證4、5之組合足以證明系爭專利請求項3不具進步性：

(一)系爭專利請求項3依附於請求項1，包含請求項1全部技術特徵，而請求項1不具進步性，已如前述。

(二)原證5說明書第【0086】段揭露「……將處理腔室100的內部階段性地加壓至第2壓力P2，例如0.9Mpa（圖15的工程B2……」。其中「將處理腔室100的內部階段性地加壓至第2壓力P2，例如0.9Mpa」代表將一定數量之氣體分子輸入處理腔室使其壓力提升可對應系爭專利請求項3「其中在步驟(b)中至少一該氣體具有一預定數量的氣體分子，該預定數量的氣體分子使該處理腔室保持在該預定壓力」。原證4、原證5雖未直接揭露氣體壓力上升與處理腔室內溫度分佈均勻性之關係，惟原證4、原證5均已揭露輸入氣體至處理腔體，該處理腔體內壓力增加表示其密度亦增加，意味著單位體積內有更多氣體分子。這些分子作為熱傳導的載體，能更有效地傳遞熱量，故可輕易得知腔室內溫度分佈更均勻係壓力上升之

必然結果，故可對應系爭專利請求項3「藉由該預定數量的氣體分子控制該處理腔室內氣體溫度分佈的均勻性」。

(三)綜上，原證4、5之組合已揭露系爭專利請求項3「如請求項1之利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法，其中在步驟(b)中至少一該氣體具有一預定數量的氣體分子，該預定數量的氣體分子使該處理腔室保持在該預定壓力，藉由該預定數量的氣體分子控制該處理腔室內氣體溫度分佈的均勻性」全部技術特徵，原證4、5均揭露提高處理腔體內之壓力至特定值，雖原證4並未直接揭露「抑制材料翹曲」，然對所屬技術領域具通常知識者而言，複數晶片受較強之氣體推壓力可抑制其翹曲係原證4實質隱含之內容其作用均是要防止晶片翹曲，而原證5直接揭露防止翹曲，故原證4、5具功能或作用之共通性，所屬技術領域具通常知識者當有充足動機能組合原證4、5之技術內容以完成系爭專利請求項3之發明，故原證4、5之組合足以證明系爭專利請求項3不具進步性。

七、原證4、5之組合足以證明系爭專利請求項4不具進步性：

(一)系爭專利請求項4依附於請求項1，包含請求項1全部技術特徵，而請求項1不具進步性，已如前述。

(二)原證5說明書第【0102】段揭露「加熱晶圓W的第二溫度T2（200℃~270℃）僅為示例，可以根據不同條件任意設定」。其中「第二溫度T2（200℃~270℃）」可對應系爭專利請求項4「其中該處理腔室內之該第一預定溫度之設定介於60℃至1500℃的範圍」。

(三)綜上，原證4、5之組合已揭露系爭專利請求項4「如請求項1之利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法，其中該處理腔室內之該第一預定溫度之設定介於60℃至1500℃的範圍」全部技術特徵，原證4、5均揭露提高處理腔室內之壓力至特定值，其作用均是要防止晶片翹曲（原證4實質隱含，原證5直接揭露），故具有功能或作用之共通性，所屬技術領域具通

01 常知識者當有充足動機能組合原證4、5之技術內容以完成系
02 爭專利請求項4之發明，故原證4、5之組合足以證明系爭專
03 利請求項4不具進步性。

04 八、原證4、5之組合足以證明系爭專利請求項5不具進步性：

05 (一)系爭專利請求項5依附於請求項1，包含請求項1全部技術特
06 徵，而請求項1不具進步性，已如前述。

07 (二)原證5說明書第【0075】段揭露「將加熱機構151的溫度下降
08 到第三溫度T3，例如室溫，以將晶圓W冷卻到第三溫度T
09 3……此時，晶圓W的冷卻速率例如設定為1.5°C/sec以下。
10 在此，如果快速冷卻晶圓W，接合的晶片C可能會翹曲，但如
11 此緩慢地冷卻晶圓W可以抑制晶片C的翹曲」。雖然原證5說
12 明書第【0075】段所記載之技術內容與原證5圖15、16所揭
13 露者分屬不同實施例，惟其均係相似的接合製程，包含升
14 溫、維持、降溫的步驟，T3在前開二實施例中都代表降溫階
15 段的溫度，況系爭專利說明書通篇均未記載將處理腔室內之
16 第二預定溫度控制在大於25°C至等於100°C的範圍究竟有何
17 不可預期之功效，故原證5「將加熱機構151的溫度下降到第
18 三溫度T3，例如室溫」可對應系爭專利請求項5「其中該處
19 理腔室內之該第二預定溫度之設定在大於25°C至等於100°C
20 的範圍，且該第二預定溫度小於該第一預定溫度」。

21 (三)綜上，原證4、5之組合已揭露系爭專利請求項5「如請求項1
22 之利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法，其中該處理腔室
23 內之該第二預定溫度之設定在大於25°C至等於100°C的範
24 圍，且該第二預定溫度小於該第一預定溫度」全部技術特
25 徵。原證4、5均揭露提高處理腔室內之壓力至特定值，其作
26 用均是要防止晶片翹曲(原證4實質隱含，原證5直接揭露)，
27 故具有功能或作用之共通性，所屬技術領域具通常知識者當
28 有充足動機能組合原證4、5之技術內容以完成系爭專利請求

01 項5之發明，故原證4、5之組合足以證明系爭專利請求項5不
02 具進步性。

03 九、原證4、5之組合足以證明系爭專利請求項6不具進步性：

04 (一)系爭專利請求項6依附於請求項1，包含請求項1全部技術特
05 徵，而請求項1不具進步性，已如前述。

06 (二)原證5說明書第【0086】段揭露「將晶圓W保持在與載置台15
07 0上方分離的狀態，將處理腔室100的內部逐步加壓至第二壓
08 力P2，例如0.9MPa（圖15的步驟B2）……」其中「將處理腔
09 室100的內部逐步加壓至第二壓力P2，例如0.9MPa」經換算
10 後約為8.88atm，故可對應系爭專利請求項6「處理腔室內之
11 該預定壓力之設定在大於1.3大氣壓(atm)至小於100大氣壓
12 (atm)的範圍」。

13 (三)綜上，原證4、5之組合已揭露系爭專利請求項6「如請求項1
14 之利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法，其中該處理腔室
15 內之該預定壓力之設定在大於1.3大氣壓(atm)至小於100大
16 氣壓(atm)的範圍」全部技術特徵。原證4、5均揭露提高處
17 理腔室內之壓力至特定值，其作用均是要防止晶片翹曲(原
18 證4實質隱含，原證5直接揭露)，故具有功能或作用之共通
19 性，所屬技術領域具通常知識者當有充足動機能組合原證
20 4、5之技術內容以完成系爭專利請求項6之發明，故原證4、
21 5之組合足以證明系爭專利請求項6不具進步性。

22 十、原處分並無違反專利法第75條及行政程序法第102條規定：

23 (一)原處分作成時即現行專利法第75條規定：「專利專責機關於
24 舉發審查時，在舉發聲明範圍內，得依職權審酌舉發人未提
25 出之理由及證據，並應通知專利權人限期答辯；屆期未答辯
26 者，逕予審查。」又行政程序法第102條規定：「行政機關
27 作成限制或剝奪人民自由或權利之行政處分前，除已依第39
28 條規定，通知處分相對人陳述意見，或決定舉行聽證者外，

01 應給予該處分相對人陳述意見之機會。但法規另有規定者，
02 從其規定。」

03 (二)原處分作成時之專利審查基準（2019年版）第五篇第一章
04 「專利權之舉發」4.4.1「職權審查之時機及範圍」規定：
05 「職權審查係審查人員於舉發人爭點以外，基於公益目的而
06 例外發動的審查措施，應審慎為之，且發動時機及範圍有其
07 限制。……職權審查僅限於舉發聲明範圍內之請求項，審
08 酌舉發人所未提出之理由及證據。例如舉發聲明範圍僅請求
09 撤銷系爭專利請求項1至3者，縱使其他請求項亦有應撤銷之
10 事由，尚不得發動職權審查。」4.4.2「通知專利權人答辯
11 之義務」：「審查人員發動職權審查進而引入舉發人所未提
12 出之證據或理由，為避免造成突襲，應檢附相關證據並就職
13 權審查部分敘明理由，給予專利權人答辯之機會。」

14 (三)比對參加人所提之舉發理由書及原處分引用原證4、5之內
15 容：

16 1.舉發理由書引用原證4說明書第【0012】、【0055】至【0
17 062】、【0063】-【0068】段，原處分則引用原證4說明
18 書第【0066】、【0061】段，故原處分並未逸脫舉發理由
19 書所指陳原證4之範圍。

20 2.舉發理由書引用原證5說明書第【0064】段（用於解釋圖8
21 和圖9中所示的接合過程）、第【0066】至【0074】段
22 （配合圖8和圖9，用於說明步驟 A3-A5《等溫加壓、等壓
23 升溫、等溫等壓》）、第【0072】段（特別是第1至2行，
24 描述加熱機構151的溫度上升以及晶圓W的加熱過程）、第
25 【0075】段（描述步驟 A6《持壓降溫》，包括加熱機構1
26 51 溫度降低、晶圓W冷卻以及第三溫度T3的設定）、【00
27 89】段（用於說明在工序B2中，晶圓W如何被間接加
28 熱）、圖8、圖9（流程圖和說明圖，用於說明接合過程中的
29 壓力、溫度變化）、及圖10（用於說明接合工序中晶圓

W的狀態)。原處分則引用原證5說明書第【0066】、【0069】、【0072】、【0073】、【0075】、【0076】、【0089】段、圖8及圖9。故除第【0076】段外，原處分並未逸脫舉發理由書所指陳原證5之範圍。

3.原證4與原證5為同一申請人，二者核心發明內容（利用可密閉處理腔室、載置台、加熱機構及氣體供給機構，通過加熱和加壓氣體實現晶片與基本結合避免基板翹曲）、裝置核心結構（兩者代表圖均為圖7且結構標號完全一致）、基本操作原理具有高度相似性，僅在製程中的溫度、壓力施加時序上存有差異。原處分第8至9頁之理由(五)、1.、(6)已敘明原證4、5具高度關聯性，旨在說明原證5與原證4所揭露技術內容的互通性，二者說明書技術內容高度相同甚至部分完全相同，故將原證5與原證4共通之技術內容與系爭專利請求項1部分元件進行比對，難謂逾越參加人原舉發理由範圍（例如原證5與原證4都揭露防止基板翹曲的技術內容，均可對應系爭專利請求項1要件編號1A；原證5與原證4都揭露一處理腔室100，均可對應系爭專利請求項1要件編號1B）。縱經本院審酌後未採用原證5實施例一（圖9），而原證5另一實施例二（圖16）已揭露與系爭專利請求項1要件編號1C、1D完全相符之製程，此業經本院依智慧財產案件審理法第6條第4項規定，命當事人就原證5圖16表示意見，本院即得以之為裁判基礎（如前第四、(一)、2.項所述），故原告前開主張理由即不足採。

(四)參加人於舉發階段提出原證4至原證6，雖未具體指明何者為最接近之先前技術，然觀諸其所主張之具體事實，以及對各具體事實與證據間關係之敘明，參加人當時應係以原證4為主要引證，以原證5、6為其他引證。而依原處分第4至16頁之理由「(五)爭點之判斷」，被告則以原證5為主要引證，以原證4、6為其他引證。固然參加人之舉發理由與被告所為之

01 原處分，就主要引證及所為技術特徵比對有別，惟本件存在
02 原證4至原證6之多數引證案，各引證如何結合，本屬參加人
03 已提出之理由及證據，專利專責機關即被告在舉發聲明及爭
04 點範圍內本得予以判斷，並無原告所指職權審查之情事，則
05 被告於原告與參加人為陳述後，於比對時係依據舉發理由與
06 證據所揭示之技術特徵為整體比對，作成原處分，並無原告
07 所稱未予原告限期答辯機會，被告無裁量空間，違反專利法
08 第75條及行政程序第102條規定之情事。再者，參加人於本
09 院審理時表明以原證5為主要引證（本院卷二第150頁），本
10 院業已逐項就各爭點詳列明細命當事人陳述意見，並於準備
11 程序及言詞辯論程序詳由當事人言詞辯論，是以兩造及參加
12 人對於此爭執，已於本院審理時為充分攻防，本院認定無論
13 主要引證為原證5或原證4，經整體技術特徵比對，原證4及
14 原證5之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

15 (五)專利經提出舉發者，專利權人即應自行評估是否提出更正，
16 尤其是可能舉發成立之專利權，專利權人提出更正，如符合
17 更正相關規定，可能使該專利獲得存活之機會，就行政訴訟
18 中應否保障專利權人之更正權，涉及專利權人、舉發人及社
19 會公眾間相互對立之利益權衡，同時攸關當事人紛爭一次解
20 決及訴訟經濟之考量，現行智慧財產案件審理制度，法院於
21 民事事件對於專利有效性得自為判斷，且於行政事件得審理
22 同一撤銷理由之新證據（智慧財產案件審理法第41條、第70
23 條規定參照），為調和各方利益保障，並維護程序之公平，
24 本院曾詢問原告主引證為原證4或原證5，對於技術認定有無
25 差別？假設原告於原處分階段知悉以原證5為主引證，原告
26 有無更正可能性？原告主張主引證不同，在思考上一定有所
27 不同，且抽象上一定會有更正可能性，就本件具體個案上需
28 與當事人討論等等（本院卷二第151頁），嗣具狀稱因其已
29 無從於訴訟程序中針對權利範圍進行更正，其更正利益當然

01 受到影響，被告程序瑕疵並不會因訴願程序或訴訟程序給予
02 陳述意見機會即當然補正云云。因本件被告及參加人仍援引
03 原舉發證據，本院已曉諭爭點並賦予當事人就系爭專利之有
04 效性充分辯論機會，亦詢問原告有無更正可能性，經其自行
05 評估後復未表明其更正專利權之具體需求，本院自得依全案
06 事證直接判斷系爭專利之有效性，毋庸發回命被告再就主引
07 證選擇之順位另為處分之必要。

08 (六)原告又主張原處分逕自引用第TZ000000000A、CZ000000000
09 A、CZ000000000A號案為輔助證據，認定系爭專利請求項2不
10 具進步性，逾越參加人主張理由及證據範圍，未通知原告答
11 辯云云。

12 1.原處分作成時之專利審查基準（2017年版）第二篇第三章
13 「專利要件」3.6「審查注意事項」第(5)點規定；「認定
14 申請專利之發明不具進步性時，原則上應檢附相關先前技
15 術之引證文件，惟若該技術係一般知識（參照本章3.2.1
16 「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」）時，得無須
17 檢附引證文件，但應於審查意見通知及核駁審定書中充分
18 敘明理由。」

19 2.原處分第12頁之理由(五)、2.、(2)認為系爭專利請求項2所
20 界定之用以抑制材料翹曲之加壓氣體為一空氣及/或一氮
21 氣係一般知識(參本院卷一第68至69頁)，為符合發明專利
22 審查基準前開規定充分敘明理由，被告機關提供三個系爭
23 專利之先前技術（即TZ000000000A、CZ000000000A、CZ00
24 0000000A）作為輔助證據用以說明在系爭專利申請前，以
25 空氣或氮氣作為加壓氣體已為該技術領域文獻多次揭露，
26 屬一般知識，已符合前開發明專利審查基準之規定，況被
27 告亦於同段陳明「以上先前技術之專利文獻，係用以佐證
28 處理腔室之加壓氣體使用空氣或氮氣僅係該技術領域於申
29 請當時之通常知識，其用以證明證據1所揭露加壓氣體之

01 輔助證據，非為比對系爭專利之新證據」，故原告前開主
02 張委無可採。

03 (七)至原告主張被告未於舉發階段命參加人提出原證5全文中譯
04 本即作成原處分，並援引最高行政法院104年度判字第78號
05 行政判決見解為據。然專利審查基準第五篇第一章「專利權
06 之舉發」4.3.2.2.2「外文證據與其中譯本」規定：「證
07 明文件為外文者，審查時，認有必要時，得通知申請人檢附
08 中文譯本或節譯本。證據為外文書證者，得通知舉發人檢附
09 該證據與事實有關之部分的中文譯本或節譯本。若外文書證
10 中已清楚揭露足堪比對之圖式，則無中文譯本之必要。中文
11 譯本與外文不符或舉發人未補送中文譯本者，仍應依證據審
12 究之。」準此，就外文證據之中譯本，審查人員如認無必
13 要，即無需通知舉發人檢附，且中文譯本若與外文不符或舉
14 發人未補送中文譯本者，舉發人員仍應依證據審究之，並非
15 將該外文證據予以排除。又前開最高行政法院判決指明該案
16 參加人未提出正確之中譯本，致舉發審定處分、訴願決定及
17 一審法院判決均基於錯誤之引證事實，且足以動搖其判斷基
18 礎，其結論自難其正確，故而廢棄一審判決，與本件參加人
19 雖至本院審理時始提出中譯本，但未影響就原證5之技術判
20 斷之正確性有所不同。故原告此部分主張尚無可採。

21 □、綜上所述，經整體技術特徵比對，原證4、原證5之組合或原
22 證4、5、6之組合足以證明系爭專利請求項1至6不具進步
23 性，且原處分並無違反專利法第75條及行政程序法第102條
24 規定，被告所為上開系爭專利請求項舉發成立之處分，即屬
25 合法，訴願決定予以維持，亦無不合，原告訴請撤銷，為無
26 理由，應予駁回。

27 □、本件事證已明，當事人其餘主張或答辯，已與本件判決結果
28 無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

29 柒、結論：

依智慧財產案件審理法第2條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 114 年 5 月 28 日

智慧財產第一庭

審判長法 官 汪漢卿

法 官 陳端宜

法 官 蔡惠如

以上正本係照原本作成。

一、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，逕以裁定駁回。

三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。

得不委任律師 為訴訟代理人 之情形	所 需 要 件
(一)符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1. 上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2. 稅務行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。

	3. 專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
(二) 非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	1. 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2. 稅務行政事件，具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4. 上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。
是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明文書影本及委任書。	

02 中 華 民 國 114 年 6 月 9 日

03 書記官 邱于婷